

## N2000

### 硅 NPN 外延平面晶体管芯片(4 " )

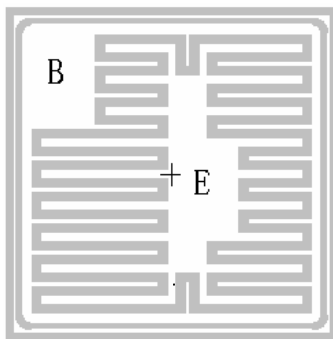
■用途:

- \* 电源调整管
- \* 音频功率放大器
- \* 其他电子电路

■特征:

- \*优越的  $h_{FE}$  线性
- \*与 P2000 配对
- \*有效图形数 1800 只

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	2000 $\mu$ m $\times$ 2000 $\mu$ m
压焊区尺寸	基区: 430 $\mu$ m $\times$ 620 $\mu$ m 发射区: 430 $\mu$ m $\times$ 620 $\mu$ m
芯片厚度	270 $\pm$ 20 $\mu$ m
锯片槽宽度	80 $\mu$ m
金属层	正面:Al 3.5 $\pm$ 0.4 $\mu$ m 背面:Ag 1.4 $\pm$ 0.2 $\mu$ m

■电特性(Ta=25°C)

参数名称	符号	测试条件	最小值					最大值	单位
			A	B	C	D	E		
集电极-基极击穿电压	$BV_{CBO}$	$I_C=0.1mA, I_E=0$	80	100	150	180	220		V
集电极-发射极击穿电压	$BV_{CEO}$	$I_C=10mA, I_B=0$	60	80	120	150	200		V
发射极-基极击穿电压	$BV_{EBO}$	$I_B=0.1mA, I_C=0$	7						V
集电极-基极截止电流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=0.9BV_{CBO}, I_E=0$						1	$\mu$ A
发射极-基极截止电流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=10V, I_C=0$						1	$\mu$ A
直流电流增益	$h_{FE}$	$V_{CE}=5V, I_C=1A$	65					350	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CES}$	$I_C=3A, I_B=0.3A$						1.5	V
特征频率	$f_T$	$V_{CE}=5V, I_C=1A$	10						MHz